

## 2SB1321, 2SB1321A

## シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形

低周波出力増幅およびドライブ用

2SD1992, 2SD1992A とコンプリメンタリ

## ■ 特長

- 2SD1992, 2SD1992Aとコンプリメンタリペア。
- ラジアルテーピング対応が可能。
- コレクタ損失の値が大きい。(600mW)

## ■ 絶対最大定格 (Ta=25°C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CBO</sub>	-30	V
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CEO</sub>	-25	V
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EBO</sub>	-7	V
せん頭コレクタ電流	I <sub>CP</sub>	-1	A
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	-500	mA
コレクタ損失	P <sub>C</sub>	600	mW
接合部温度	T <sub>j</sub>	150	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55~+150	°C

## ■ 電気的特性 (Ta=25°C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> = -20V, I <sub>E</sub> = 0			-0.1	μA
	I <sub>CEO</sub>	V <sub>CE</sub> = -20V, I <sub>B</sub> = 0			-1	μA
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CBO</sub>	I <sub>C</sub> = -10 μA, I <sub>E</sub> = 0	-30			V
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> = -2 mA, I <sub>B</sub> = 0	-25			V
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> = -10 μA, I <sub>C</sub> = 0	-7			V
直流電流増幅率	h <sub>FE1</sub> *1	V <sub>CE</sub> = -10V, I <sub>C</sub> = -10mA	85	160	340	
	h <sub>FE2</sub>	V <sub>CE</sub> = -10V, I <sub>C</sub> = -500mA*2	40	90		
トランジション周波数	f <sub>T</sub>	V <sub>CB</sub> = -10V, I <sub>E</sub> = 10mA, f = 200MHz		200		MHz
コレクタ出力容量	C <sub>ob</sub>	V <sub>CB</sub> = -10V, I <sub>E</sub> = 0, f = 1 MHz		6	15	pF

\*2 パルス測定

\*1 h<sub>FE1</sub> ランク分類

ランク	Q	R	S
h <sub>FE1</sub>	85~170	120~240	170~340

